

**Статьи из журнала «Успехи прикладной физики»,
переведенные и опубликованные в англоязычных журналах в 2019 году**

Статьи в журнале Plasma Physics Reports

1	<p><i>V. L. Bychkov, K. I. Deshko and V. A. Chernikov</i> Stimulated Ignition and Quenching of the Cathode Spot in a Low-Power Discharge with Plasma Injection // Plasma Phys. Rep. 2019. Vol. 45. No. 10. P. 973</p>
	<p><i>В. Л. Бычков, К. И. Дешко, В. А. Черников</i> Стимулированное зажигание и гашение катодного пятна в маломощном разряде с плазменной инжекцией // Успехи прикладной физики. 2018. Том 6. № 5. С. 373</p>
2	<p><i>I. G. Grigoryeva, V. A. Kostyushin and G. Kh. Salakhutdinov</i> Dynamics of Pulsed X-Ray Radiation of a Plasma Micropinch Discharge // Plasma Phys. Rep. 2019. Vol. 45. No. 11. P. 1066</p>
	<p><i>И. Г. Григорьева, В. А. Костюшин, Г. Х. Салахутдинов</i> Динамика импульсного рентгеновского излучения плазмы микропинчового разряда // Успехи прикладной физики. 2019. Том 7. № 2. С. 107</p>
3	<p><i>M. B. Shavelkina, R. Kh. Amirov, D. I. Kavyrshin and D. I. Yusupov</i> Plasma Jet-Assisted Synthesis of Graphene Using a DC Plasma Torch // Plasma Phys. Rep. 2019. Vol. 45. No. 11. P. 1080</p>
	<p><i>М. Б. Шавелкина, Р. Х. Амиров, Д. И. Кавыршин, Д. И. Юсупов</i> Синтез графена в плазменных струях электродугового плазмотрона // Успехи прикладной физики. 2019. Том 7. № 2. С. 97</p>

Статьи в журнале Journal of Communications Technology and Electronics

1	<p><i>A. V. Zverev, A. O. Suslyakov, I. V. Sabinina, G. Yu. Sidorov, M. V. Yakushev, V. D. Kuzmin, V. S. Varavin, V. G. Remesnik, Yu. S. Makarov, A. V. Predein, D. V. Gorshkov, S. A. Dvoretzky, V. V. Vasil'ev, Yu. G. Sidorov, A. V. Latyshev and I. I. Kremis</i> Photodetectors with 384 × 288 Matrix Elements for the Infrared Range of 8–10 Microns // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1024</p>
	<p><i>А. В. Зверев, А. О. Суслияков, И. В. Сабинина, Г. Ю. Сидоров, М. В. Якушев, В. Д. Кузьмин, В. С. Варавин, В. Г. Ремесник, Ю. С. Макаров, А. В. Предеин, Д. В. Горшков, С. А. Дворецкий, В. В. Васильев, Ю. Г. Сидоров, А. В. Латышев, И. И. Кремис</i> Матричные фотоприемные устройства формата 384×288 элементов для ИК-диапазона 8–10 мкм // Успехи прикладной физики. 2018. Том 6. № 3. С. 224</p>
2	<p><i>V. A. Kholodnov</i> On the Theory of a Photocurrent Burst in an Intrinsic Photoresistor upon Longitudinal and Transverse Illumination // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1038</p>

	<p><i>V. A. Холоднов</i> К теории исследования всплеска фототока собственного фоторезистора при продольной и поперечной облученности // Успехи прикладной физики. 2018. Том 6. № 6. С. 485</p>
3	<p><i>N. I. Iakovleva, A.V. Nikonov, K. O. Boltar and M. V. Sednev</i> Analysis of Current–Voltage Characteristics in UV AlGaN Heterostructure FPAs // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1046</p>
	<p><i>Н. И. Яковлева, А. В. Никонов, К. О. Болтарь, М. В. Седнев</i> Анализ механизмов темновых токов матриц ультрафиолетовых фотодиодов на основе гетероструктур AlGaN // Успехи прикладной физики. 2018. Том 6. № 1. С. 44</p>
4	<p><i>V. M. Bazovkin, V. S. Varavin, V. V. Vasil'ev, A. V. Glukhov, D. V. Gorshkov, S. A. Dvoretzky, A. P. Kovchavtsev, Yu. S. Makarov, D. V. Marin, I. V. Mzhelsky, V. G. Polovinkin, V. G. Remesnik, I. V. Sabinina, Yu. G. Sidorov, G. Yu. Sidorov, A. S. Stroganov, A. V. Tsarenko, M. V. Yakushev and A. V. Latyshev</i> A Megapixel Matrix Photodetector of the Middle Infrared Range // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1011</p>
	<p><i>В. М. Базовкин, В. С. Варавин, В. В. Васильев, А. В. Глухов, Д. В. Горшков, С. А. Дворецкий, А. П. Ковчавцев, Ю. С. Макаров, Д. В. Марин, И. В. Мжельский, В. Г. Половинкин, В. Г. Ремесник, И. В. Сабинина, Ю. Г. Сидоров, Г. Ю. Сидоров, А. С. Строганов, А. В. Царенко, М. В. Якушев, А. В. Латышев</i> Мегапиксельное матричное фотоприёмное устройство среднего ИК-диапазона // Успехи прикладной физики. 2018. Том 6. № 6. С. 501</p>
5	<p><i>I. D. Burlakov, P. A. Kuznetsov, I. S. Moshchev, K. O. Boltar and N. I. Yakovleva</i> Focal Plane Array Based on the InGaAs/InP Heterostructure for 3D Imaging in Short-Wave IR Range // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1016</p>
	<p><i>И. Д. Бурлаков, П. А. Кузнецов, И. С. Моцев, К. О. Болтарь, Н.И. Яковлева</i> Матричный фотоприемный модуль на основе гетероструктуры InGaAs/InP для формирователей 3D-изображений в коротковолновом ИК-диапазоне // Успехи прикладной физики. 2017. Том 5. № 4. С. 383</p>
6	<p><i>P. A. Kuznetsov and I. S. Moschev</i> Photodetector of Shortwave Infrared Range of Format 640 × 512 Elements with Increased Dynamic Range // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1034</p>
	<p><i>П.А. Кузнецов, И.С. Моцев</i> Фотоприемное устройство коротковолнового ИК-диапазона формата 640×512 элементов с увеличенным динамическим диапазоном // Успехи прикладной физики. 2018. Том 6. № 5. С. 438</p>
7	<p><i>A. S. Kashuba, E. V. Permikina, S. V. Golovin, M. R. Lakmanova and A. V. Pogozheva</i> Microstructuring of the Surface of High-Resistivity Single-Crystalline Silicon by Chemical Etching // J. Commun. Technol. Electron. 2019. Vol. 64. No. 9. P. 1030</p>
	<p><i>А. С. Кашуба, Е. В. Пермикина, С. В. Головин, М. Р. Лакманова, А. В. Погожева</i> Микроструктурирование поверхности высокоомного монокристаллического кремния химическим травлением // Успехи прикладной физики. 2017. Том 5. № 6. С. 585</p>